

Тематический указатель статей, опубликованных в 2000 году

Фундаментальные исследования

Валиев К.А., Кокин А.А. Из итогов XX века: от кванта к квантовым компьютерам. I. Физические основы и принципы построения квантового компьютера. № 4-5 стр. 46.

Валиев К.А., Кокин А.А. Из итогов XX века: от кванта к квантовым компьютерам. II. Квантовая элементная база. № 6 стр. 3.

Глазов В.М., Пашилкин А.С. Теплоемкость и термическое расширение твердого кремния. № 4-5 стр. 63.

Горбачев А.А., Жабицкий О.В. Методы зонной инженерии для систем со сложным энергетическим спектром. № 4-5 стр. 53.

Мурыгин В.И., Гундырев В.Б. Влияние нейтральных атомов примеси на экранировку электрического поля в компенсированных полупроводниках. № 3 стр. 3.

Овчинников А.С., Плис В.И., Попов А.И. Магнитооптика редкоземельных соединений в сверхсильных магнитных полях. № 4-5 стр. 58.

Материалы электронной техники

Абызов А.М., Карамид Ю. Оптические свойства пленок карбида кремния, полученных химическим осаждением из газовой фазы метилсилана. № 2 стр. 7.

Будагян Б.Г., Шерченков А.А. Высокоскоростная низкотемпературная технология некристаллических полупроводников. № 4-5 стр. 75.

Воробьев В.А., Ильяшева Е.В. Физико-химические свойства высокочастотных диэлектриков $\text{CaO} - \text{Al}_2\text{O}_3 - \text{V}_2\text{O}_5$ для толстопленочной технологии. № 1 стр. 7.

Герасименко Н.Н., Протасенко В.В., Вернер И.В., Троицкий В.Ю. Самоорганизация поверхности кремния при ионном синтезе дисилицида кобальта. № 4-5 стр. 80.

Гончар А.В., Егоров Р.Н., Катинкина С.В., Летюк Л.М., Шипко М.Н. Влияние ионов лантана на рекристаллизационные процессы в оксидных магнитах. № 2 стр. 3.

Гончаров В.А., Прокофьева В.К., Цветков А.С. Численное исследование микросегрегации при выращивании монокристаллов арсенида галлия в условиях пониженной гравитации. № 6 стр. 29.

Громов Д.Г. Взаимодействие кремниевой подложки с пленками бинарных сплавов переходных металлов. № 6 стр. 15.

Дмитриев М.В. Диэлектрические свойства стеклокерамики для разных соотношений стекла, наполнителя и продукта их взаимодействия. № 6 стр. 11.

Зимин С.П., Комаров Е.П., Рябкин Ю.В. Процессы переноса носителей заряда в структурах с толстыми слоями пористого кремния. № 1 стр. 15.

Куцев М.В., Рыгалин Б.Н., Тюрнев Н.В. Влияние условий выращивания монокристаллов кремния на осевое и радиальное распределение кислорода. № 6 стр. 23.

Неустроев С.А. О состояниях кислорода, окисляющего фоторезист ФП-383 в плазме. № 2 стр. 21.

Петрова В.З., Прокопьев Е.П., Тимошенко С.П., Дьячков С.А. Термическая обработка частиц SiO_2 , Al_2O_3 , BaO в воздушной и аргон-кислородной ВЧИ-плазме. № 2 стр. 12.

Рыгалин Б.Н., Соколов Е.Б., Прокофьева В.К. Геттерирующие примеси в монокристаллах кремния для СБИС. № 4-5 стр. 71.

Симонов Б.М., Волков В.А., Нальский А.А. Исследование динамики изменения состава растворов полимеров в микроэлектронных устройствах. № 3 стр. 16.

Тельминов А.И., Воробьев В.А., Ильешева Е.В. Свойства стекловидных материалов системы MgO - Al₂O₃ - B₂O₃. № 3 стр. 9.

Технология микроэлектроники

Гаврилов С.А., Громов Д.Г., Данилевич О.В., Мочалов А.И. Разработка селективного травителя для самосовмещенного формирования систем металлизации на основе пленок сплава Ti - Co - N. № 2 стр. 33.

Гаврилов С.А., Лемешко С.В., Роцин В.М., Соломатенко Р.В., Шевяков В.И. Исследование особенностей процесса локального окисления пленок титана с использованием сканирующей зондовой микроскопии. № 3 стр. 27.

Зенин В.В., Сегал Ю.Е., Колычев А.И. Исследование качества микросварных соединений алюминиевой проволоки в корпусах изделий электронной техники с покрытиями из никеля и его сплавов. № 2 стр. 37.

Макаров А.С., Неустроев С.А., Литвинов Ю.М., Литвинов М.Ю. Атомный механизм процесса химико-механического полирования пластин кремния. № 3 стр. 34.

Норох А.А., Андренюк В.А. Оптические средства контроля и управления транспортной системой кристалльного производства микроэлектроники. № 2 стр. 45.

Райнова Ю.П. Быстрые термические процессы: специфика, перспективы, проблемы. № 2 стр. 25.

Сеченов Д.А., Петров В.В., Черепашин И.И. Распределение постоянного электрического поля в узких окнах, вскрытых в окисле, при термополевом легировании кремния. № 3 стр. 21.

Симонов Б.М., Волков В.А., Нальский А.А. Исследование возможностей стабилизации температуры точки росы по влаге внутрикорпусной среды герметичных блоков МЭА. № 2 стр. 53.

Микроэлектроника и полупроводниковые приборы

Абрамов А.А., Горбатый И.Н. Токи двойной инжекции в полупроводниковой пластине при междолинном перераспределении электронов вблизи поверхности. № 6 стр. 41.

Амеличев В.В., Галушков А.И., Чаплыгин Ю.А., Шубин С.В. Интегральные магниточувствительные матрицы с высоким уровнем разрешения. № 1 стр. 45.

Ануфриев В.Н., Гулевич П.В., Шелепин Н.А. Методы построения источников опорного напряжения в составе интегральных микросхем. № 2 стр. 63.

Вихров С.П., Вишняков Н.В., Маслов А.А. Особенности формирования барьера в структурах металл - неупорядоченный полупроводник. № 3 стр. 48.

Гаврушко В.В., Косогов О.В., Раскин А.А. Характеристики криогенных фототранзисторов на основе антимонида индия. № 1 стр. 36.

Григорашвили Ю.Е., Фомичев М.И. Ультразвуковая система с управляемой формой зондирующего импульса. № 2 стр. 70.

Жгун С.А., Ревков А.М., Чжан Ч., Юн С.Ф., Ан Дж., Русли. Распространение ПАВ в алмазоподобных пленках на ниобате лития. № 3 стр. 55.

Зайцев Н.А., Красников Г.Я., Матюшкин И.В. Структурно-примесные комплексы в системе кремний - диоксид кремния. № 3 стр. 39.

Зайцев Н.А., Красников Г.Я., Матюшкин И.В. Структурно-примесные комплексы и электронно-ионные процессы в системе Si - SiO₂. № 6 стр. 37.

Иващенко Е.И., Цветков Ю.Б. Исследование процесса электрохимического анизотропного травления кремния. № 1 стр. 59.

Касимов Ф.Д., Гусейнов Я.Ю. Влияние конструктивно-технологических параметров на характеристики солнечных элементов на основе аморфного кремния. № 1 стр. 40.

Красников Г.Я., Зайцев Н.А., Матюшкин И.В. Влияние начального этапа окисления кремния на поведение примеси натрия в системе. Si - SiO₂. № 1 стр. 65.

Лугин А.Н. Тензозэффект в пленочных резисторах. № 6 стр. 55.

Романов В.П., Золочевский Ю.Б., Соколов А.Ю. Динамика ионных процессов в двухслойном диэлектрике структуры Mo - ФСС - SiO₂ - Si. № 1 стр. 21.

Смирнов А.И. Линейный ИК-фотопреобразователь со схемой считывания фотосигналов на основе МОП-транзисторов. № 2 стр. 75.

Тарасов Р.Ю., Тарасов Ю.А., Штерн Ю.И. Температурная стабилизация интегральных схем диодных функциональных преобразователей без опорных напряжений. № 3 стр. 65.

Усанов Д.А., Вениг С.Б., Орлов В.Е. Режимы переключения и генерации в туннельном диоде, стимулированные электромагнитным излучением. № 3 стр. 61.

Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Угрюмова Н.В. Температурные зависимости вольт-амперных характеристик СВЧ-диодов на основе *p-n*-переходов в сильном СВЧ-поле. № 1 стр. 51.

Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Ульянов Д.В. Влияние магнитного поля на работу полупроводниковых синхронизированных СВЧ-генераторов в режиме гашения мощности. № 6 стр. 49.

Устюжанинов В.Н., Фролова Т.Н., Якунина М.В. Релаксационные процессы в *p-n*-переходах при импульсном гамма-облучении в режиме обратного смещения генератором тока. № 2 стр. 57.

Хайновский В.И., Уздовский В.В., Гордо Н.М., Федоров Р.А. Моделирование процессов фоторелаксации в многоканальных объемных фоточувствительных приборах с зарядовой связью. № 1 стр. 28.

Штерн Ю.И., Боженарь Д.А. Оптимизация конструкции термоэлектрических охлаждающих устройств. № 2 стр. 80.

Схемотехника и проектирование

Абрамов И.И., Гончаренко И.А., Новик Е.Г. Численное моделирование одноэлектронных транзисторов. № 2 стр. 87.

Бубенников А.Н. Учет влияния эффектов лавинной ионизации и вытеснения тока в схемотехнических моделях интегральных транзисторов. № 6 стр. 61.

Коноплев Б.Г., Рындин Е.А., Ивченко В.Г. Исследование способов реализации СБИС на основе ПЛИС, БМК и в виде заказных микросхем. № 1 стр. 81.

Коробов А.И., Плеханов А.Е. Критерии выбора конструктивно-технологического варианта микросборки. № 1 стр. 88.

Кузнецов Е.В., Слезкин В.В. Применение метода "горизонтальной" оптимизации для идентификации параметров полупроводниковых приборов. № 6 стр. 68.

Полевиков В.В., Бочаров Ю.И., Шагулин И.И. Методика оптимизации компонентного состава базовых ячеек аналого-цифровых БИМОП базовых матричных кристаллов. № 1 стр. 71.

Микросистемы

Поголов А.И., Панкратов О.В. Микроэлектронные пьезорезистивные акселерометры. № 2 стр. 95.

Микропроцессорная техника

Бескровная С.В., Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Анализ пропускной способности каналов связи многофункциональных информационно-управляющих комплексов. № 3 стр. 76.

Комаров А.В., Михайлов С.В. Производительность локальной магистрали параллельного типа в многопроцессорной системе. № 3 стр. 73.

Комаров А.В., Михайлов С.В. Производительность локальной магистрали последовательного типа в многопроцессорной системе. № 1 стр. 97.

Сапронов М.В. Кодирование видеоизображения с использованием функции Габоора. № 3 стр. 80.

Сапронов М.В. Оценка векторов смещения для цифрового видеокadra с использованием областей нефиксированного размера. № 2 стр. 103.

Степанов Н.В. Цифровой дешифратор команд радиолокационного канала управления реактивными летательными аппаратами. № 1 стр. 101.

Интегральные радиоэлектронные устройства

Забудский Е.Е., Самохвалов М.К. Устройство управления тонкопленочной электролюминесцентной индикаторной панелью. № 3 стр. 85.

Шалумов А.С. Методология комплексного интерактивного расчета механических характеристик типовых конструкций радиоэлектронной аппаратуры на ранних этапах проектирования. № 6 стр. 75.

Методы и техника измерений

Боргардт Н.И., Максимов С.К. Исследования полупроводниковых гетероструктур электронно-микроскопическими методами. № 4-5 стр. 158.

Демидов В.Н., Гайнутдинов Р.В. Исследование метрологических характеристик поверхности полированного стекла и пленок диоксида титана. № 6 стр. 83.

Плотников А.В., Прилуцкий Д.А., Селищев С.В. Цифровой монитор для суточной регистрации ЭКГ. № 4-5 стр. 162.

Штерн Ю.И., Марков Ф.В., Боженарь Д.А., Тарасов Р.Ю. Высокоточные температурные технологии. № 4-5 стр. 167.

Биомедицинская электроника

Вайсман М.В., Прилуцкий Д.А., Селищев С.В. Алгоритм синтеза имитационных электрокардиосигналов для испытания цифровых электрокардиографов. № 6 стр. 94.

Гордин А.И., Маругин А.В. Система лазерной флоуметрии для диагностики периферийного кровообращения. № 6 стр. 89.

Маругин А.В., Королев В.Н., Цареградский В.Б. Доплеровский анализатор на основе полупроводникового лазера с волоконным измерительным каналом. № 3 стр. 93.

Проблемы высшего образования

Бархоткин В.А., Амербаев В.М. Курс криптологии на кафедре вычислительной техники МИЭТ. № 4-5 стр. 198.

Гайдуков Г.Н., Лосев В.В., Овчинников А.С. Курсы физики в учебно-методическом обеспечении новых специальностей. № 4-5 стр. 193.

Игнатова И.Г., Поспелов А.С., Чаплыгин Ю.А. Технология дистанционного обучения в МИЭТ. № 4-5 стр. 187.

Королев М.А., Ревелева М.А. Магистратура на факультете электроники и компьютерных технологий МИЭТ. № 4-5 стр. 185.

Краткие сообщения

Ершов А.В., Чучмай И.А., Хохлов А.Ф., Машин А.И., Семин Ю.А. Оптическое поглощение многослойных наноструктур $a\text{-Si/ZrO}_x$. № 1 стр. 107.

Касимов Ф.Д., Гусейнов Я.Ю., Кемерчев Г.П. Расчет толщины переходного слоя в арсенид-галлиевых $n\text{-v}$ -структурах. № 3 стр. 100.

Турулин И.И. Проектирование цифровых рекурсивных фильтров с конечной кусочно-полиномиальной импульсной характеристикой на интеграторах. № 1 стр. 110.

Турулин И.И. Цифровые рекурсивные фильтры с прореженной знакопеременной импульсной характеристикой. № 3 стр. 102.

Юбилей

8 февраля - День российской науки. № 1 стр. 3.

МИЭТ - 35 лет. № 4-5.

Валиеву К.А. - 70 лет. № 6 стр. 103.

Конференции

Мальцев П.П. Информационное сообщение о Всероссийской конференции "Сенсоры и микросистемы". № 3 стр. 105.

Райнова Ю.П. Информационное сообщение о 197 Собрании "Корпорации электрохимического Общества". № 3 стр. 104.

Вторая международная научно-практическая конференция "Современные информационные и электронные технологии". № 6 стр. 102.

Информационное сообщение о III Международной научно-технической конференции "Электроника и информатика – XXI век". № 6 стр. 101.

Микро-, нано-, оптоэлектроника*

Баринов В.В., Калинин А.В., Киреев В.Ю. Кластерное производство специализированных СБИС. № 4-5 стр. 98.

Коркишко Ю.Н., Федоров В.А. Оптические волноводы и интегрально-оптические устройства на кристаллах ниобата и танталата лития. № 4-5 стр. 107.

Королев М.А., Путря М.Г., Шевяков В.И. Особенности формирования элементов пленочных структур в интегральных КНИ-микросистемах. № 4-5 стр. 86.

Неволин В.К. Зондовая нанотехнология: достижения. № 4-5 стр. 103.

Старосельский В.И. Проектирование ИС устройств выборки и хранения на полупроводниковых соединениях $A^{III}B^V$. № 4-5 стр. 91.

Сырчин В.К., Кандыба П.Е. Источник плазмы высокой плотности. № 4-5 стр. 114.

Микросистемная техника и микросенсоры*

Вернер В.Д., Сауров А.Н. Метод самоформирования в технологии микросистем. № 4-5 стр. 118.

Волков С.И., Григорашивили Ю.Е., Ичкидидзе Л.П. Датчики на основе высокотемпературных сверхпроводников. № 4-5 стр. 128.

Галушков А.И., Чаплыгин Ю.А. Интегральные магниточувствительные микросистемы. № 4-5 стр. 124.

Микропроцессорная техника.*

Управление и обработка информации

Бархоткин В.А., Савченко Ю.В., Шипатов А.В. Современные специализированные вычислительные устройства для систем управления технологическими процессами. № 4-5 стр. 146.

Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Эффективность информационно-управляющих комплексов. № 4-5 стр. 152.

Ефимов А.В. Обобщенная система Хаара и ее применение в цифровой обработке информации. № 4-5 стр. 133.

Лисов О.И. Гомеостаз и оптимизация систем на основе мультихромосомных генетических алгоритмов. № 4-5 стр. 142.

Умняшкин С.В., Космач М.В. Оптимизация кодирования цифровых изображений по методу JPEG. № 4-5 стр. 139.

Экономические и философские проблемы развития науки и техники*

Анискин Ю.П. Основные положения концепции цикличности деловой активности предприятий. № 4-5 стр. 170.

Егоров Ю.Л. Сложность: сущность, подходы и методы исследования. № 4-5 стр. 179.

Моисеева Н.К. Конкурентоспособность предприятий как фактор экономического роста отрасли. № 4-5 стр. 174.

* Рубрика введена для специального выпуска